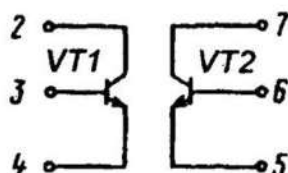


K159HT1A — K159HT1E, KP159HT1A — KP159HT1E

Микросхемы представляют собой матрицу из двух *n-p-n* транзисторов (для построения дифференциальных усилителей). Корпус типа 301.8-2, масса не более 1,3 г и типа 201 14-1, масса не более 1 г.



Электрическая схема K159HT1, KP159HT1

Назначение выводов. 1, 8 — свободные; 2 — коллектор транзистора VT1; 3 — база транзистора VT1; 4 — эмиттер транзистора VT1; 5 — эмиттер транзистора VT2; 6 — база транзистора VT2; 7 — коллектор транзистора VT2

Электрические параметры

Разность напряжений эмиттер-база транзисторов:

K159HT1A, KP159HT1A, K159HT1Б,	
KP159HT1Б, K159HT1В, KP159HT1В . . .	≤ 3 мВ
K159HT1Г, KP159HT1Г, K159HT1Д,	
KP159HT1Д, K159HT1Е, KP159HT1Е . . .	≤ 15 мВ

Прямое падение напряжения между эмиттером и базой ($I_b = 1 \text{ mA}$)	0,55...0,75 В
Обратный ток коллектор-база	≤ 200 нА
Обратный ток эмиттер-база	≤ 500 нА
Ток утечки между транзисторами VT1 и VT2 при $U = 20 \text{ В}$	≤ 20 нА

Коэффициент усиления по току (при $U_{кб} = 5В$,
 $I_э = 1 мА$):

К159НТ1А, КР159НТ1А, К159НТ1Г, КР159НТ1Г	20.. 80
К159НТ1Б, КР159НТ1Б, К159НТ1Д, КР159НТ1Д	60 .. 180
К159НТ1В, КР159НТ1В, К159НТ1Е, КР159НТ1Е	> 80
Емкость коллектора на частоте 10 МГц	≤ 4 пФ
Емкость эмиттера на частоте 10 кГц .	≤ 5 пФ

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение коллектор-база	20 В
Напряжение эмиттер-база	4 В
Напряжение между транзисторами .	20 В
Ток коллектора постоянный	10 мА
Ток коллектора импульсный ($t_{и} = 30 мкс$)	40 мА
Рассеиваемая мощность (при $T = - 60...+ 70^{\circ} С$)	50 мВт